

Перв. примен.		Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание				
Справ. №			Конденсаторы К53-68 АЖЯР.673546.007ТУ								
			Конденсаторы К10-84б ФЦТА.673516.016ТУ								
		С1	К53-68"Е"-50В-10,0 мкФ±10%			1					
		С2	К10-84б 5750М-50В-Н90-2,2 мкФ-N-A			1					
		С3	К10-84б 2012М-50В-Н20-4700 пФ±10%-N-A			1					
		С4	К53-68"Е"-50В-10,0 мкФ±10%			1					
		С5	К10-84б 2012М-50В-Н20-4700 пФ±10%-N-A			1					
		С6, С7	К10-84б 2012М-50В-М47-33 пФ±10%-N-A			2					
		С8-С10	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			3					
		С11	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,01 мкФ±10%-N-A			1					
		С12	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			1					
		С13-С15	К53-68"D"-25В-1,0 мкФ±10%			3					
		С16-С20	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			5					
		С21, С22	К53-68"С"-25В-10,0 мкФ±10%			2					
		С23, С24	К10-84б 5750М-50В-Н90-2,2 мкФ-N-A			2					
С25	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			1							
С26	К10-84б 3216М-25В-Н20-2,2 мкФ±10%-N-A			1							
С27, С28	К53-68"С"-25В-10,0 мкФ±10%			2							
С29	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			1							
С30	К53-68"D"-25В-10,0 мкФ±10%			1							
С31, С32	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			2							
С33	К53-68"D"-25В-15,0 мкФ±10%			1							
С34	К53-68"D"-25В-10,0 мкФ±10%			1							
С35	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			1							
С36, С37	К53-68"С"-25В-10,0 мкФ±10%			2							
С38-С41	К10-84б 3216М-25В-Н20-0,15 мкФ±10%-N-A			4							
Подп. и дата											
							9М6.673.175ПЭЗ				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.	Разраб.	Зарифуллин			Плата управления по тангажу			Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Рузанов								1	5
								9М			
	Н. контр.	Халикова									
	Утв.	Шайхуллин									

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
C42		K10-848 5750M-50B-H90-2,2 мкФ-N-A			1		
C43-C50		K10-848 3216M-25B-H20-0,15 мкФ±10%-N-A			8		
		Модули электропитания БКЯЮ.436630.001ТУ					
DA1		МДМ5-1Е09МП			1		
DA2		МДМ3-2Е1515МП			1		
		Микросхемы 140УД31АТ1 ВК АЕЯР.431130.171-17ТУ					
		Микросхемы 1335ЕН5П АЕЯР.431420.809ТУ					
		Микросхемы 5321ЕН04Г4 АЕНВ.431420.461-02ТУ					
		Микросхемы 5321ЕН03Г5 АЕНВ.432420.461-02ТУ					
		Микросхемы 5321ЕМ06Б5 АЕНВ.431420.461-03ТУ					
DA3, DA4		140УД31АТ1 ВК			2		
DA5		1335ЕН5П			1		
DA6		5321ЕН04Г4			1		
DA7		5321ЕН03Г5			1		
DA8		5321ЕМ06Б5			1		
DA9		140УД31АТ1 ВК			1		
		Микросхемы					
DD1		5559ИН14АУ АЕЯР.431230.652ТУ			1		
DD2		1986ВЕ92У1 АЕЯР.431290.711ТУ			1		
L1		Дроссель ДФПК7,5-2/0,4 БКЮС.670109.002-01ТУ			1		
		Резисторы Р1 ОЖ0.467.164ТУ					
		Резисторы СПЗ-19а2-0,5 ОЖ0.468.134ТУ					
R1-R8		P1-8В-0,25-10 кОм±5%-Т-А-М			8		
R9		P1-8В-0,25-24 кОм±5%-Т-А-М			1		
R10		P1-8В-0,25-10 кОм±5%-Т-А-М			1		
R11, R12		P1-8В-0,25-62 Ом±5%-Т-А-М			2		
R13, R14		P1-8В-0,25-300 Ом±5%-Т-А-М			2		
Инв. № подл.					9М6.673.175ПЭЗ		Лист
							2
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			Дата

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание			
Инв. № подл.	Подп. и дата	R15, R16	P1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М			2			
		R17	СПЗ-19а2-0,5-1 кОм±10%			1			
		R18	P1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R19	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R20	P1-8МП-0,25-1,78 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R21	P1-8МП-0,25-9,09 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R22, R23	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			2			
		R24	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R25	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R26	P1-8В-0,25-5,1 Ом±5%-Т-А-М			1			
		R27-R30	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			4			
		R31	P1-8МП-0,25-20 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R32	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R33	СПЗ-19а2-0,5-47 кОм±10%			1			
		R34	P1-8МП-0,25-30,1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R35	P1-8МП-0,25-20 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R36-R38	P1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М			3			
		R39	P1-8МП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R40	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R41	P1-8МП-0,25-301 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R42	P1-8В-0,25-1 кОм±5%-Т-А-М			1			
		R43	P1-8МП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R44	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R45*	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			1	51,1 кОм; 100 кОм,		
							допускается не		
							устанавливать		
		R46	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R47	P1-8МП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R48	P1-8В-0,25-510 Ом±5%-Т-А-М			1			
		R49*, R50*	P1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М			2	30,1 кОм; 51,1 кОм; 100 кОм		
		R51	P1-8МП-0,25-5,11 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		R52	P1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М			1			
		Инв. № подл.	Подп. и дата					9М6.673.175ПЭЗ	Лист
									3
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

9M6.673.175ПЭЗ

Муст

5